Date d'édition : 05.11.2026

Ref : 578772

Transistor à éffet de champ J112

Transistor à effet de champ pour la réalisation d'expériences de base dans le domaine de l'électronique.

Caractéristiques techniques:
- FET à canal N
- Puissance dissipée : max. 625 mW
- Applications : étages d'entrée à haute impédance

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Electicité/Electronique > Électricité/électronique (STE) > Transistors STE